Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☑; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☑; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Hữu Lâm

2. Ngày tháng năm sinh: 26/10/1974; Nam ☑; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☑

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): B6, lô 8, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): B6, lô 8, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: 02438516239; Điện thoại di động: 0989096174;

E-mail: lam.nguyenhuu@hust.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 09,1999 đến tháng, năm 09,2001: Giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội

Từ tháng, năm 09,2001 đến tháng, năm 09,2004: Nghiên cứu sinh tại ĐH Paris XI (Paris Saclay)

Từ tháng, năm 09,2004 đến tháng, năm 12,2006: Giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội

Từ tháng, năm 09,2006 đến tháng, năm 09,2008: phó trưởng Bộ môn Vật liệu điện tử, Viện Vật lý kỹ thuật tại Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội

Từ tháng, năm 02,2007 đến tháng, năm 04,2007: Thực tập xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến tiếng Anh ngành Khoa học vật liệu tại Đại học Illinois

Từ tháng, năm 09,2007 đến tháng, năm 11,2007: Thực tập chuyên sâu về công nghệ nano (epitaxy) tại ĐH Paris XI (Paris Saclay)

Từ tháng, năm 09,2008 đến tháng, năm 09,2018: Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật kiêm trưởng Bộ môn Vật liệu điện tử tại Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội

Từ tháng, năm 09,2018 đến tháng, năm 05,2020: phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật, phó Bí thư Đảng ủy bộ phận VLKT tại Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội

Từ tháng, năm 05,2020 đến tháng, năm 07,2021: Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật- Bí thư Đảng ủy Vật lý kỹ thuật tại Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội

Chức vụ: Hiện nay: Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật- Bí thư Đảng ủy Vật lý kỹ thuật; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Viện trưởng

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Vật lý kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: C10-101, Trường ĐHBK Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 02438693350

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): không

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): không

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 26 tháng 05 năm 1997, số văn bằng: B32175, ngành: Vật lý kỹ thuật, chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng ThS [4] ngày 03 tháng 07 năm 2000, số văn bằng: 15726, ngành: Vật lý kỹ thuật, chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng TS [5] ngày 05 tháng 12 năm 2005, số văn bằng: PARXI 5146452, ngành: Điện tử, chuyên ngành: Cấu trúc nano và vi hệ thống cho điện tử và thông tin; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Paris 11 (Paris Sud), Cộng hòa Pháp

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 10 tháng 11 năm 2011, ngành: Vật lý

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim, Hóa học)

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu có cấu trúc một chiều trên cơ sở dây nano silic (Si NW) và ống nano cácbon (CNT);

- Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu tổ hợp trên cơ sở CNT/Graphene (hoặc GO)/hạt nano kim loại hoặc nano ôxit kim loại bán dẫn.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) ... HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành 4 đề tài NCKH cấp Bộ; 1 đề tài NCKH cấp Cơ sở;

- Đã công bố (số lượng) 101 bài báo khoa học, trong đó 33 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 1 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT	Bộ GD-ĐT	2015
2	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT	Bộ GD-ĐT	2018
3	Chứng nhận khen thưởng hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì cấp Bộ	Bộ GD-ĐT	2008

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

a) Về hoạt động đào tạo:

- Mức độ hoàn thành khối lượng giảng dạy: Đảm bảo định mức và số giờ chuẩn giảng dạy.

- Hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của giảng viên, được đánh giá hàng năm đạt A* (hoàn thành xuất sắc).

- Năng lực giảng dạy: Đảm bảo năng lực giảng dạy các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành cho đại học và học phần sau đại học; Tham gia giảng dạy các học phần chương trình tiên tiến ngành Khoa học vật liệu bằng tiếng Anh; Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học, đồ án môn học cho sinh viên đại học, luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật và ngành Khoa học vật liệu;

- Ý kiến phản hồi của người học trong 3 năm gần nhất: Đánh giá Tốt

- Phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng KHCN: Tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của các ngành: Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý y khoa của Trường ĐHBK Hà Nội.

- Đóng góp khác trong công tác đào tạo: Viết 01 giáo trình cho sinh viên trình độ đại học; Là thành viên HĐ Khoa học và đào tạo của Trường ĐHBK Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

b) Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

- Năng lực nghiên cứu: Có năng lực nghiên cứu khoa học, Chủ nhiệm 02 đề tài Quỹ, 02 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài hợp tác VLIR đã nghiệm thu Đạt, tham gia một số đề tài cấp Bộ và Nhà nước khác với vai trò thành viên nghiên cứu;

- Kết quả công bố và xuất bản: Đã công bố gần 100 công trình khoa học, trong đó hơn 30 công bố quốc tế ISI, Scopus; là đồng tác giả của 01 Bằng sáng chế độc quyền;

- Tổ chức nghiên cứu: Có khả năng tổ chức nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài khoa học.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học: Tham gia tổ chức và hỗ trợ một số hội thảo như Hội nghị tinh thể học châu Á 2018, các hội nghị Khoa học vật liệu (SPMS), Hội nghị chiếu sáng, Hội thảo hợp tác với ĐH Pusan, Hàn quốc; thành viên Ban tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý châu Á tổ chức tại Hà Nội năm 2018, thành viên BTC hội nghị quốc tế IWAMSN 2021 tổ chức 8/2021, thành viên BTC Hội nghị Vật lý toàn quốc 8/2021…

- Uy tín khoa học trong cộng đồng (***Google scholar, H-index, thành viên Hội đồng biên tập tạp chí có uy tín,….***): có chỉ số H-index =11; i10-index =11 (Google Scholar)

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số 20 năm.
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức(*)
		Chính	**Phụ**			**ĐH**	**SĐH**	

1	2015-2016					242	108	350/505.3/189
2	2016-2017	1			1	262.4	36	298.4/471.4/189
3	2017-2018	1			5	206.6		206.6/424.6/189
03 năm học cuối								
4	2018-2019	1			2	194.6	90	284.6/430.6/189
5	2019-2020	1			3	226.4	90	316.4/448.4/189
6	2020-2021				2	184.4	90	274.4/364.4/162

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☑:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☑ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Cộng Hòa Pháp năm 2004

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☑:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Giảng dạy 02 học phần bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến liên tục trong 3 năm

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/ CK2/ BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/ CK2/ BSNT	Chính	Phụ			
1	Dương Vũ Trường	X		X		05/2014 đến 12/2020	Trường ĐH Bách khoa Hà Nội	07/05/2021
2	Nguyễn Quang Lịch	X		X		05/2010 đến 01/2016	Trường ĐH Bách khoa Hà Nội	31/08/2016
3	Nguyễn Thị Thúy	X			X	05/2010 đến 10/2016	Trường ĐH Bách khoa Hà Nội	05/10/2017

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi được công nhận PGS/TS							

1	Vật lý và kỹ thuật chân không	GT	NXB Bách khoa Hà Nội, năm 2020	1	MM		Quyết định số 98/QĐ-ĐHBK-ĐT và Xác nhận của Viện Vật lý kỹ thuật

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 1 ([1])

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	**Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)**	**CN/PCN/TK**	**Mã số và cấp quản lý**	**Thời gian thực hiện**	**Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả**	
Trước khi được công nhận PGS/TS						
1	Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhớ hình dạng màng mỏng bằng phương pháp phún xạ	CN	B2008-01-186, cấp Bộ	1/1/2008 đến 30/12/2009	Đã nghiệm thu, Đạt, ngày 30 tháng 6 năm 2010	
2	Chế tạo carbon nanotube bằng phương pháp lắng đọng hoá học từ pha hơi và một số ứng dụng	CN	B2005-28-195, cấp Bộ	1/1/2005 đến 30/12/2006	Đã nghiệm thu, Đạt, ngày 27 tháng 7 năm 2007	

3	Tổng hợp ống nano cácbon bằng phương pháp CVD cho ứng dụng làm nguồn phát xạ điện tử trường (ĐT hợp tác quốc tế)	CN	Ap06 \Prj3\nr06, cấp Cơ sở	1/4/2006 đến 30/3/2008	Đã nghiệm thu, Đạt, ngày 31 tháng 3 năm 2008	
Sau khi được công nhận PGS/TS						
4	Chế tạo cảm biến nhạy khí trên cơ sở sử dụng cấu trúc nano 1 chiều (ống nano cácbon và dây nano silic)	CN	NAFOSTED 103.02-2015.05, cấp Bộ	1/5/2016 đến 30/4/2019	Đã nghiệm thu, Đạt, ngày 25 tháng 1 năm 2019	
5	Nghiên cứu, chế tạo chấm lượng tử, dây lượng tử silic và germany bằng phương pháp phún xạ	CN	NAFOSTED 103.02 -99.09, cấp Bộ	1/12/2009 đến 1/12/2012	Đã nghiệm thu, Đạt, ngày 26 tháng 6 năm 2013	

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi được công nhận PGS/TS								
1	Kinetics of Ge growth at low temperature on Si(001) by UHV-CVD	10	Không	Journal of Applied Physics	Tạp chí QY uy tín - SCI ***IF: 2.8***	72	97, 64907	06/2005
2	UHV-CVD growth anh annealing of thin fully relaxed Ge films on Si(001)	11	Không	Optical Materials	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 1.8***	36	27, 822	02/2005
3	Role of point defects on the optical properties of self-assembled Ge/Si hut clusters	8	Không	Journal of Crystal Growth	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 1.9***		275, 1287	02/2005

4	Synthesis of multi-walled carbon nanotubes for NH3 gas detection	6	Có	Physica E	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 3.8***	51	37, 54	02/2007
5	Selective Si growth on partially desorbed SiO2/Si(001) surfaces	6	Có	Superlattices and Microstructures	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 2.2***	5	44, 348	03/2008
6	Kinetic formation and optical properties of Ge/Si hut clusters grown by UHV-CVD	5	Không	Materials Science in Semiconductor Processing	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 3.2***		8, 41	01/2005
7	Kinetics of selective epitaxial growth of Si and relaxed Ge by ultrahigh vacuum chemical vapor deposition in Si(001) windows	8	Không	Materials Science in Semiconductor Processing	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 3.2***	7	9, 460	10/2006

8	Some Insights into the relaxation mechanisms of Germanium growing on (001) Si by Ultrahigh Vacuum Chemical Vapor Deposition	4	Không	ECS Transactions	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 0.4***	4	3, 7, 569	07/2006
9	CdS sensitized ZnO electrodes in photoelectrochemical cells	4	Không	Advanced in Natural Science: Nanoscience and nanotechnology	Tạp chí QT uy tín - SCIE	13	1, 35010	11/2010
10	Investigation of field emission from vertically aligned carbon nanotubes	8	Có	Advanced in Natural Science: Nanoscience and nanotechnology	Tạp chí QT uy tín - SCIE		2, 215	04/2009
11	Effect of Sintering on Electrical Property of Samaria Doped Ceria	4	Không	Advanced in Natural Sciences			3, 273	11/2007

12	Synthesis of Samaria Doped Ceria for Solid Oxide Fuel Cells	4	Không	Communications in Physics			17, 177	09/2007
13	Chế tạo màng mỏng nhớ hình NiTi bằng phương pháp đồng phún xạ	3	Có	Tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật			75, 116	05/2010
14	Ảnh hưởng điều kiện công nghệ tới sự hình thành ống nano cacbon chế tạo bằng phương pháp CVD	7	Có	Tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật			57, 101	07/2006
15	Nghiên cứu tính chất của màng ZnO pha tạp Al,Ga chế tạo bằng phương pháp phún xạ	3	Có	Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, năm 2009			226	02/2010

16	Khảo sát ảnh hưởng của quá trình ủ nhiệt tới cấu trúc và tính chất phát xạ điện tử của ống nanô cácbon	2	Có	Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, năm 2009			497	02/2010
17	Formation of Carbon Nanotubes for Field Emission Application	2	Có	Proc of The 5th Korea-Vietnam Inter. Joint Symp. Advanced Materials: Advanced Materials and Their Processing				11/2008
18	Synthesis of Multi-walled and single-walled carbon nanotubes by thermal CVD method	8	Có	Proceedings of the Eleventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering			82	04/2008
19	Khảo sát đặc tính phát xạ điện tử của sợi nano cácbon chế tạo bằng phương pháp CVD	6	Có	Tuyển tập báo cáo Hội nghị VLCR toàn quốc lần 5			781	11/2007

20	Effect of Sintering on Electrical Property of Samaria Doped Ceria	4	Không	Tuyển tập báo cáo Hội nghị VLCR toàn quốc lần 5			524	11/2007
21	Investigation of Field Emission from vertically aligned CNTs	8	Có	First International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2007			256	11/2007
22	Synthesis and Characterisation of nanocrystalline CeO2-based electrolytes by co-precipitation	6	Không	First International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2007			350	11/2007
23	Synthesis of Carbon Nanotubes by CVD method and application	5	Có	The 10th Asia Pacific Physics Conference				10/2007
24	Formation and optical, electrical properties of Ge quantum dots grown on Si (001) patterned substrates	3	Có	Proceedings of the Eighth German-Vietnam Seminar on Physics and Engineering			110	02/2006

25	Chế tạo sợi CNTs bằng phương pháp CVD và một số ứng dụng	9	Có	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý TQ lần thứ VI			815	06/2006
26	Influence of growing condition on the formation of multi-walled carbon nanotubes	6	Có	Proc of the International Conference on Engineering Physics			424	10/2006
27	Effects of sinterng time and heating rate on microstructure of samaria doped ceria	4	Không	Proc of the International Conference on Engineering Physics			350	10/2006
28	Structural Characterization of Carbon Spheres and carbon Nanotubes	4	Có	Procf the Inter. Workshop on Functional Mater and Inter. Workshop on Nanophysics and Nanotech			133	12/2006
29	Synthesis of Carbon Nanotubes for Gas Sensing Application	9	Có	Proc the 1st Vietnamese-Italian Symposium on Photonics & Nanotech			45	11/2005

30	Synthesis and characterization of nano-crystalline Sm-doped CeO2	5	Không	Proc the 1st Vietnamese-Italian Symposium on Photonics & Nanotech			97	11/2005
31	Characterization of Carbon Nanotubes Synthesized by Thermal CVD	8	Có	Frontiers of Basic Sicence: Toward New Physics Earth and Space Science Mathematic			319	11/2005
32	Growth of carbon nanotubes by chemical vapor deposition	8	Có	Proc of the First Young Vietnamese Scientists Meeting				06/2005
33	Investigation the influence of temperature and purification to the NH3 sensitive characteristics of CNT carpet	4	Có	The 5th Inter Workshop on Adv Materials Science and Nanotech, 2010 (IWAMSN2010),				11/2010
34	Silion nanowires fabrication by sputtering method	4	Có	The 5th Inter Workshop on Adv Materials Science and Nanotech, 2010 (IWAMSN2010),				11/2010

35	Fabrication and characterization of NiTi shape memory alloy thin film	3	Có	The 5th Inter Workshop on Adv Materials Science and Nanotech, 2010 (IWAMSN2010),				11/2010
36	Charactirization of AZO and AGZO thin films deposited by magnetron sputtering	3	Có	The 5th Inter Workshop on Adv Materials Science and Nanotech, 2010 (IWAMSN2010),				11/2010
37	Selective growth of Ge quantum dots on chemically prepared SiO2/Si(001) surfaces	5	Có	Material Science and Engineering B	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 4.7***	28	101, 199	10/2003
38	Selective epitaxial growth of Ge quantum dots on patterned SiO2 /Si(001) surfaces	11	Có	Applied Surface Science	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 6.3***	14	224, 134	02/2004
39	Vertical ordering in multilayers of self-assembled Ge/ Si(001) quantum dots	7	Không	Journal of Vacuum Science and Technology B	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 1.6***	17	20, 1259	06/2002

40	Kinetics of the heteroepitaxial growth of Ge layer at low temperature on Si(001) in UHV-CVD	7	Không	Physica Status Solidi (a)	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 1.8***	6	201, 329	01/2004
41	Growth and optical properties of Ge/Si quantum dots formed on patterned SiO2/Si(001) substrates	5	Có	Physica E	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 3.8***	6	23, 471	02/2004
42	Formation and properties of selectively grown Ge/Si quantum dots	9	Có	Superlattices and Microstructures	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 2.2***	2	36, 193	07/2004
43	Epitaxial growth of IV-IV nanostructures by UHV-CVD for optoelectronic and electronic devices	7	Không	Proceedings of the 9th Asia Pacific Physics Conference			221	12/2005

44	An analytical model for the drain current of short-channel MOSFETs	3	Có	Proceedings of the third international workshop on materials science			246	11/1999
45	Xác định nồng độ pha tạp kênh của MOSFET	3	Có	Tuyển tập Báo cáo Hội nghi Vô tuyến Điện tử Toàn quốc lần thứ VII			274	11/1998
Sau khi được công nhận PGS/TS								
46	Functionalization-Mediated Preparation via Acid Precipitation and Photocatalytic Activity of In Situ Ag2WO4@WO3.H2O Nanoplates	10	Không	ECS Journal of Solid State Science and Technology	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 2.14***		110, 54009	05/2021
47	Eco-Friendly Synthesis and Applicability to Silver Ink of Silver Nanoparticles Prepared via Stepwise-Modified Tollens Method	4	Không	Journal of Nanoscience and Nanotechnology	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 0.8***		21, 2568	02/2021

48	Ultralow-detection limit ammonia gas sensors at room temperature based on MWCNT/WO3 nanocomposite and effect of humidity	5	Có	Solid State Sciences	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 2.14***		113, 106534	01/2021
49	Simple controlling eco-friendly synthesis of silver nanoparticles at room temperature using lemon juice extract & commercial rice vinegar	6	Không	Journal of Nanotechnology	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 1.05***		4	05/2020
50	Development of NH3 Gas Sensors at Room Temperature Based on Modified - CNTs	7	Có	Materials Transactions	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 0.8***		61, 1540	07/2020

51	Constraint effect caused by graphene on in situ grown Gr@WO3 - nanobrick hybrid material	7	Không	Ceramics International	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 3.8***	5	46, 8711	01/2020
52	Composition of CNT and WO3 nanoplate: synthesis and NH3 gas sensing characteristics at low temperature	6	Có	Jour. Metal. Matt. Min	Tạp chí QT - ESCI	3	24, 61	07/2019
53	Synergistic enhancement of NH3 gas-sensing properties at low temperature by compositing carbon nanotubes with WO3 nanobricks	4	Không	Vacuum	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 2.9***	11	168, 108861	08/2019

54	Surface-Modified Carbon Nanotubes for Enhanced Ammonia Gas Sensitivity at Room Temperature	3	Có	Journal of Nanoscience and Nanotechnology	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 0.8***	3	79, 7447	11/2019
55	Enhancement of the NH3 gas sensitivity by using the WO3/MWCNT composite-based sensors	6	Có	Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	Tạp chí QT - ESCI		10, 15001	01/2019
56	Structural and Optical Properties of Si-Core /SiOx Shell Nanowires	6	Có	Journal of Electronic Materials	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 1.8***		46, 3422	01/2017
57	Pt- and Ag-Decorated Carbon Nanotube Network Layers for Enhanced NH3 Gas Sensitivity at Room Temperature	9	Có	Materials Transactions	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 0.8***	8	56, 1399	06/2015

58	Scalable fabrication of SnO2 thin films sensitized with CuO islands for enhanced H2S gas sensing performance	8	Không	Applied Surface Science	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 6.3***	35	324, 280	01/2015
59	Preparation and ethanol sensing properties of flower-like cupric oxide hierarchical nanorods	6	Không	Materials Science in Semiconductor Processing	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 3.2***	17	26, 18	11/2014
60	Growth of silicon nanowires by sputtering and evaporation methods	7	Có	Physica Status Solidi (a)	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 1.8***	2	110, 1429	05/2013
61	Enhancement of NH3 gas sensitivity at room temperature by carbon nanotube-based sensor coated with Co nanoparticles	5	Có	Sensors	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 4***	100	13, 1754	01/2013

62	Tổng hợp vật liệu tổ hợp trực tiếp rGO/thanh nano NiO bằng phương pháp nhiệt thủy phân và nghiên cứu tính chất vật liệu tổ hợp	4	Không	Journal of Science and Technology			2, 119	04/2021
63	WO3 nanoplates: facile synthesis, controllable oxygen deficiency and photocatalytic activity	8	Không	Communications in Physics			30, 319	10/2020
64	Ammonia gas sensing properties at low temperatures of nanocomposites of graphene oxide and tungsten oxide nanobricks	8	Không	Vietnam journal of science and technology			58, 282	03/2020

65	Khảo sát đặc tính nhạy khí amôniắc ở nhiệt độ phòng trên cơ sở tổ hợp SnO2/CNTs	4	Không	Hội nghị KHKT đo lường toàn quốc			651	09/2020
66	Cảm biến khí NH3 trên cơ sở dây nano silic	3	Có	Tạp chí KH-CN Các trường Đại học Kĩ thuật			137, 89	09/2019
67	Simple Manipulating Optical and Photocatalytic Properties of Tungsten Oxide Nanostructures Synthesized by Hydrothermal Method	8	Không	Proceedings of the 4th international conference on advanced materials and nanotechnology			128	10/2019
68	Investigation the Effect of Ag Content on Adsorption Ability and Optical Properties of Ag-doped WO3 Nanoparticles	7	Không	Proceedings of the 4th international conference on advanced materials and nanotechnology			170	10/2019

69	Facile Synthesis of CNT/WO3 Nanoplates Composite with Enhanced Photocatalytic Characteristic	9	Không	Proceedings of the 4th international conference on advanced materials and nanotechnology			142	10/2019
70	In-situ Gr@WO3 Nanobrick Hybrid Material: Synthesis , Optical, Photocatalytic Properties	10	Không	Proceedings of the 4th international conference on advanced materials and nanotechnology			155	10/2019
71	CNT/Graphene/Metal Oxide Semiconductor Nanoparticles Hybrid Composites for NH3 Gas Detection	8	Có	Proceedings of the 4th international conference on advanced materials and nanotechnology			102	10/2019
72	Investigation the effect of preparation time on structural, optical&photocatalytic properties of WO3.H2O nanoplate	6	Không	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019			775	11/2019

73	Chế tạo đế SERS bằng phương pháp đơn giản sử dụng dây nano silic và hạt nano bạc tổng hợp bằng phương pháp xanh	8	Không	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019			492	11/2019
74	Facile synthesis and effect of annealing temperature on optical and photocatytic properties of tungsten oxide nanoplates	6	Không	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019			632	11/2019
75	Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần và độ ẩm lên cảm biến nhạy khí dựa trên vật liệu tổ hợp CNT/WO3	6	Có	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019			578	11/2019

76	Ag-doped tungsten oxide nanoparticles – synthesis and antibacterial activity study	6	Không	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019			496	11/2019
77	chế tạo tổ hợp cácbon (cnt, go) / ôxít kẽm (zno) sử dụng làm vật liệu cảm biến nhạy khí	7	Có	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019			582	11/2019
78	Tailoring The Structure And Morphology of WO3 Nanostructures by Hydrothermal Method	10	Không	Journal of Science and Technology			56, 127	03/2018

79	Effect of acidity on formation, structure, morphology, andoptical properties of tungsten oxide nanostructures prepared by acid precipitation method	5	Không	Proceedings of the 9th International Workship on Advanced Materials Science and Nanotechnology			370	11/2018
80	Size control of Ag nanoparticles by green synthesis	4	Không	Proceedings of the 9th International Workship on Advanced Materials Science and Nanotechnology			364	11/2018
81	Synthesis high crystallinity and dispersibility WO3 nanostructures by hydrothermal method in highly acidic environment	4	Không	Proceedings of the 9th International Workship on Advanced Materials Science and Nanotechnology			377	11/2018

82	Ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình tổng hợp hạt nano Ag sử dụng axít citric làm chất hoạt động bề mặt	7	Không	Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc - SPMS 2017			813	10/2017
83	Hybrid materials based on carbon nanotube	2	Không	Journal of Science and Technology			54, 159	12/2016
84	Effect of synthesizing parameters on morphology and diameter of carbon nanotubes grown by thermal CVD method	3	Không	Journal of Science and Technology			54, 91	12/2016
85	Silicon nanowires fabrication by physical method	5	Có	Journal of Science and Technology			54, 169	12/2016
86	Cấu trúc lõi/vỏ và sự phát huỳnh quang của dây nanô silic	5	Có	Tạp chí khoa học và công nghệ Các trường Đại học Kĩ thuật			116, 63	02/2017

87	Ảnh hưởng của kim loại xúc tác khi tổng hợp ống nano cácbon bằng phương pháp CVD nhiệt	2	Không	Tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật			116, 72	02/2017
88	Chế tạo và nghiên cứu hiệu ứng giam giữ lượng tử của dây nano Silic mọc định hướng thẳng	6	Có	Hội nghị VLCR và KHVL toàn quốc lần thứ 9 (SPMS2015),			259	11/2015
89	Nghiên cứu chế tạo Panel LED đơn sắc và phân bố quang học	6	Không	Hội nghị VLCR và KHVL toàn quốc lần thứ 9 (SPMS2015),			267	11/2015
90	Tăng cường tính nhạy khí NH3 của cảm biến trên cơ sở ống nano cacsbon bằng cách phủ hạt nano kim loại	3	Có	Tạp chí Khoa học và Công nghệ			52, 225	05/2015

91	Nghiên cứu chế tạo màng bán dẫn Cu2Sn3S7 định hướng ứng dụng trong pin mặt trời.	7	Không	Tạp chí Khoa học và Công nghệ			52, 219	05/2015
92	Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Cu2SnS3 làm lớp hấp thụ trong pin mặt trời hiệu suất cao	10	Không	Tạp chí Khoa học và Công nghệ			52, 203	05/2015
93	Tính chất vật lý của màng Sn1-xCuxS (x=0, 0,05, 0,10 và 0,15)	8	Không	Tạp chí Khoa học và Công nghệ			52, 453	05/2015
94	Nghiên cứu tính chất của màng mỏng AGZO pha tạp bằng phương pháp phún xạ	3	Có	Tạp chí Khoa học và Công nghệ			52, 460	05/2015
95	Nghiên cứu mô phỏng cấu trúc pin mặt trời ZnO/CdS/Sn1-xCuxS/Mo	8	Không	Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8			260	12/2014

96	Chế tạo dây nano Si bằng phương pháp bốc bay nhiệt	7	Có	Tạp chí KH-CN Các trường Đại học Kĩ thuật			90, 114	08/2012
97	Khảo sát tính nhạy khí amôniắc chọn lọc tại nhiệt độ phòng sử dụng cảm biến trên cơ sở ống nano cácbon	6	Có	Tạp chí phát triển KH-CN			15, 62	12/2012
98	Characterization of Al and (Al, Ga)-doped ZnO thin films deposited by magnetron sputtering	4	Có	The 6th Vietnam-Korea International Joint Symposium on Advanced Materials and Their Processing			81	11/2011
99	Silicon nanowires grown by thermal evaporation method	5	Có	The 6th Vietnam-Korea International Joint Symposium on Advanced Materials and Their Processing			17	11/2011
100	Study the sensitive and selective effect of multi-walled carbon nanotubes to NH3 gas	5	Có	The 6th Vietnam-Korea International Joint Symposium on Advanced Materials and Their Processing			89	11/2011

101	Effects of acidity on the formation and adsorption activity of tungsten oxide nanostructures prepared via the acid precipitation method	4	Không	Materials Chemistry and Physics	Tạp chí QT uy tín - SCI ***IF: 4.04***		272, 125014	07/2021

- Trong đó, số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 9 ([48] [50] [52] [54] [55] [56] [57] [60] [61])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố ***(Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)***

TT	**Tên bài báo/báo cáo KH**	**Số tác giả**	**Là tác giả chính**	**Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN**	**Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành**	**Tập, số, trang**	**Tháng, năm công bố**
Không có							

- Trong đó, số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS:

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	**Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích**	**Tên cơ quan cấp**	**Ngày tháng năm cấp**	**Tác giả chính/ đồng tác giả**	**Số tác giả**
Sau khi được công nhận PGS/TS					

1	Cảm biến khí NH3 dạng màng và thiết bị đo khí NH3	Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ	20/11/2018	Đặng Đức Vượng (Tác giả chính)/ Nguyễn Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hữu Lâm	4

- Trong đó, số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): 1

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự):

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú

1	Phát triển Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật (đại học và sau đại học)	Chủ trì	Quyết định số 130/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2020 và số 930/ QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 5 tháng 5 năm 2017	Trường ĐHBK Hà Nội	QĐ số 111/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2020 phê duyệt và ban hành bộ CTĐT tích hợp CN-Thạc sĩ.	Chương trình đào tạo năm 2017 của ĐHBK Hà Nội, CTĐT tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ 2020, CTĐT Tiến sĩ các ngành Vật lý kỹ thuật, Vật lý chất rắn, Vật lý LT&VLT
2	Phát triển Chương trình đào tạo ngành Vật lý y khoa (trình độ cử nhân)	Chủ trì	Quyết định số 359/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 8 tháng 2 năm 2021	Trường ĐHBK Hà Nội	QĐ số 701/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 phê duyệt đề án mở ngành và ban hành CTĐT CN Vật lý y khoa	Chương trình đào tạo Cử nhân Vật lý y khoa 2021

3	Phát triển Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hạt nhân	Tham gia	Quyết định năm 2017 của ĐHBK Hà Nội	Trường ĐHBK Hà Nội	QĐ số 111/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2020 phê duyệt và ban hành bộ CTĐT tích hợp CN-Thạc sĩ.	Chương trình đào tạo 2017 của ĐHBK Hà Nội, CTĐT tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ, tích hợp Cử nhân-Kỹ sư KTHN năm 2020

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không

đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: Có 01 giáo trình Đại học Vật lý và kỹ thuật chân không, xuất bản 2020, NXB Bách khoa Hà Nội, viết một mình.

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: Đề xuất 03 CTKH bù điểm sách: số 53, 58, 59

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)